1000 Ω Die resistore a film sottile GaAs

LCRES-R1000OHM — 1000 Ω Die resistore a film sottile GaAs.

Resistenza: 1000 Ω (tipico); Corrente di funzionamento lineare: 0.04 A (tipico); Corrente massima ammissibile: 0.08 A (massimo). Dimensioni planari del die: 0.5 × 0.5 mm.



Caratteristiche elettriche

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Numero di resistori	-	-	-	-	1	-
Numero di terminali	-	-	-	-	2	-
Resistenza	-	-	1000	-	-	Ω
Tolleranza della resistenza	-	-	±5	-	-	%
Corrente di funzionamento lineare	-	-	0.04	-	-	A

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Corrente massima ammissibile	-	-	-	0.08	A

Condizioni ambientali

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	125	°C

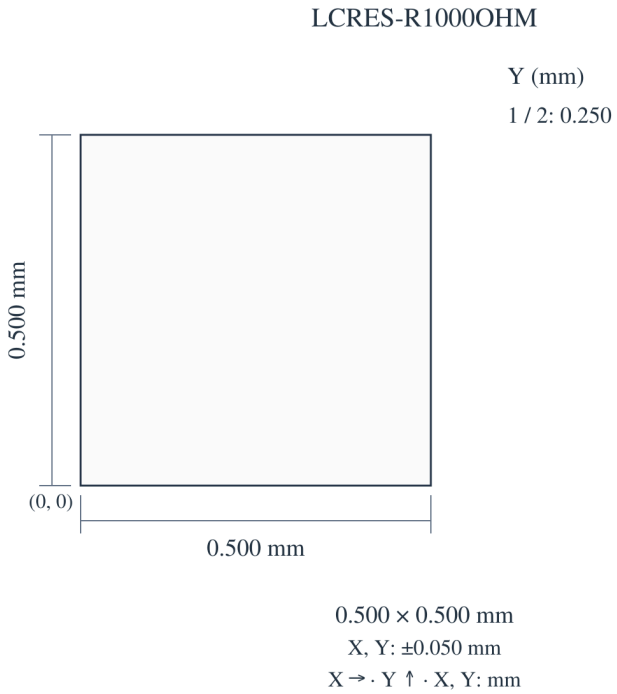
Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	Funzione	Note
1, 2	IN/OUT	Ingresso/uscita reciproco	-
Retro del chip	GND	Massa	RF / DC GND

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni planari del die	0.5 × 0.5	mm

Disegno di riferimento con alcune quote in mm. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono i disegni completi.



Pubblicazione corrente · 1.3 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.2.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Il retro del die richiede un collegamento a massa affidabile.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.